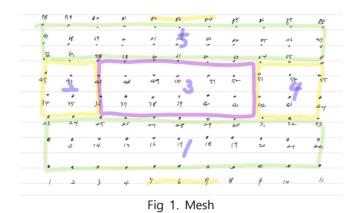
# Homework #13

20221059 정상목

## 1. Mesh

이번 과제에서 사용할 mesh는 다음과 같다.



이번 과제에서 사용한 mesh는 Double gate mosfet의 구조를 가지고 있다. 이 구조는 3가지 Region으로 각각 ox, si, ox 순서로 구성되어 있다. 각 Region은 왼쪽부터 Region 1, Region 2, Region 3로 설정했다. 각 Region별 vertex수는 다음 표와 같습니다.

Region 1	Region 2	Region 3	Region 4	Region 5	entire
33	12	28	12	33	118

Table 1. Number of vertex

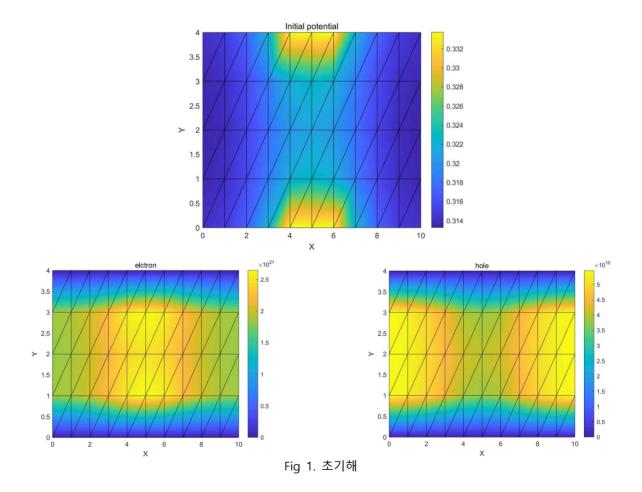
#### 2. HW#10

Nonlinear Poisson 을 푸는 코드가 잘 동작하지 않아 새롭게 수정하였습니다. 결과는 다음과 같습니다.

먼저 초기해를 구하기 위해 charge부분에 doping density만을 고려하여 초기 potential을 구할 수 있었습니다. 이때 구한 potential을 바탕으로 n과 p의 농도를 구했습니다. 사용한 식은 다음과 같습니다.

$$\begin{array}{l} \nabla ~ \bullet ~ (- \, \nabla \, \epsilon \phi) = q \, ( \, N_{dop}^+ ) \\ \\ n = n_i c^{\frac{\phi}{V_i}} \\ \\ p = n_i c^{-\frac{\phi}{V_i}} \end{array}$$

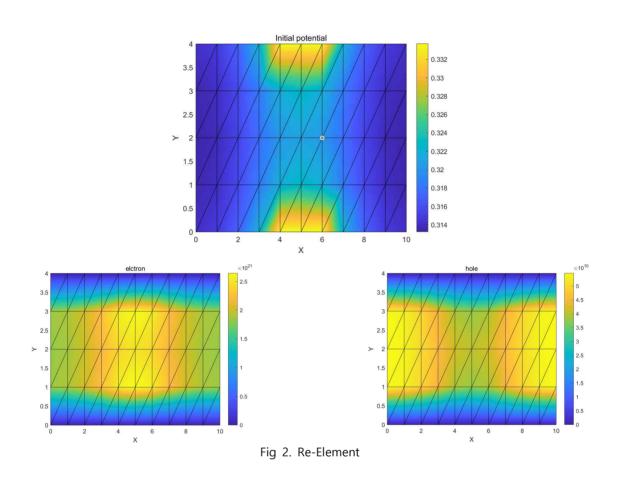
이 초기해의 결과는 다음과 같습니다.



그림상으로는 ox region에서 potential과 carreier density가 변하는 것처럼 보이지만 node수가 적어 색이 그렇게 보이는 것이다.

## 3. Newton method

앞서 얻은 값을 초기해로 삼아서 nonlinear possion 방정식을 풀어주었다. 이때 solution vector는 si region에서 [phi1; n1; p1; phi2; n2; p2; phi3; n3; p3]로 9x1 행렬을 만들어 주었고 이에 따라 Jacobian matrix로 9x9행렬이 되었다. 결과는 다음과 같다.



20번의 반복을 수행했고 약 5회부터 수렴이 진행됨을 확인할 수 있었다.

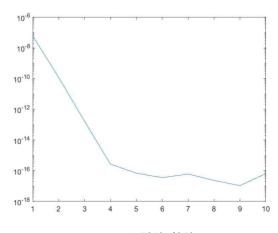
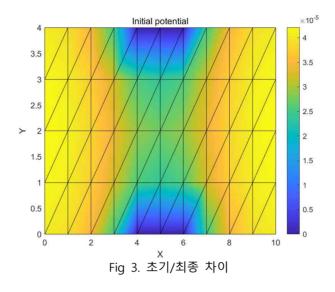


Fig 3. 수렴성 확인

최종적으로 초기 해와 최종 해를 비교해 얼마나 차이가 발생했는지 확인했다.



contact으로 지정해준 부분에서 멀어질수록 차이가 많이 발생했음을 확인했다.

## 4. Drift-diffusion

앞서 얻은 possion 방정식을 활용해 drift-diffusion 모델을 시도했다. scharfetter-gummel scheme을 이용하여 Jn와 Jp를 정리했고 phi, n, p에 대해 각각 편미분해주어 jaco를 만들어 주었지만 수렴하지 않아 현재 확인중에 있습니다.